



1060nm SOA 半导体光放大器

见合八方1060nm波长的半导体光放大器（SOA）芯片系列专为高增益，高功率，低偏振和宽谱SOA模块而设计。可满足客户快速订制需求，同时具备交期短供货快、性价比好、可靠性高等优点。

产品特点

- ◆ 高增益，低功耗
- ◆ 全国产化产品，交付及时
- ◆ 定制化服务：可支持保偏、集成隔离器、集成 PD 光功率监控等更高集成度的器件订制

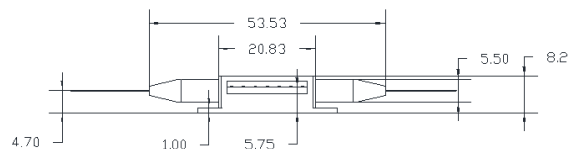
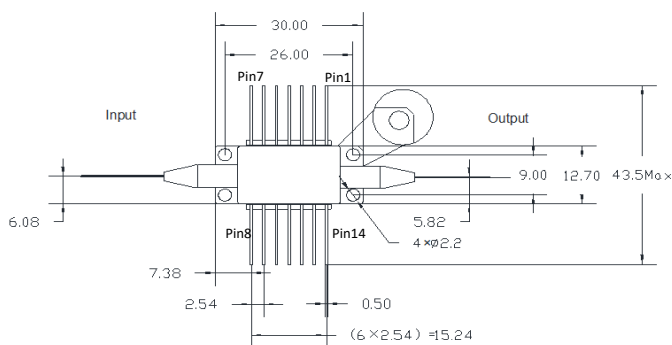
产品应用

- ◆ OCT 医疗应用
- ◆ 扫频源，可调激光器

产品规格（芯片温度@25℃）

参数	符号	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
ASE 中心波长	λ_{ASE}	25℃, $I_f=400mA$	---	1070	---	nm
工作波长	λ	25℃, $P_{in}=0dBm$	---	1060	---	nm
-3dB 增益谱宽	$\Delta\lambda$	$P_{in}=-20dBm$	---	50	---	nm
最大光功率	P_{max}	$I_f=400mA$, $P_{in}=5dBm@1060nm$	---	15	---	dBm
小信号增益	SSG	$I_f=400mA$, $P_{in}=-25dBm@1060nm$	---	25	---	dB
偏振相关增益	PDG	25℃, $I_f=400mA$	---	10	---	dB
噪声系数	NF	25℃, $I_f=400mA@1060nm$	---	8	10	dB
工作电流	I_f	---	---	400	600	mA
正向电压	V_f	---	---	---	2	V
TEC 电流	I_{TEC}	---	---	---	1.8	A
TEC 电压	V_{TEC}	---	---	---	3.4	V
热敏电阻阻值	R_{therm}	$T=25^\circ C$	9.5	10	10.5	K Ω
热敏电阻电流	I_{therm}	---	---	---	5	mA
气密性 ¹		$T=25^\circ C$	$1*10^{-12}$	$1*10^{-11}$	$1*10^{-8}$	Pa.m ³ /s
工作温度	T_c	$I=I_{op}$	-10	---	70	℃
存储温度	T_{stg}	---	---	---	85	℃
总功耗	P	---	---	---	4	W

结构尺寸和管脚定义

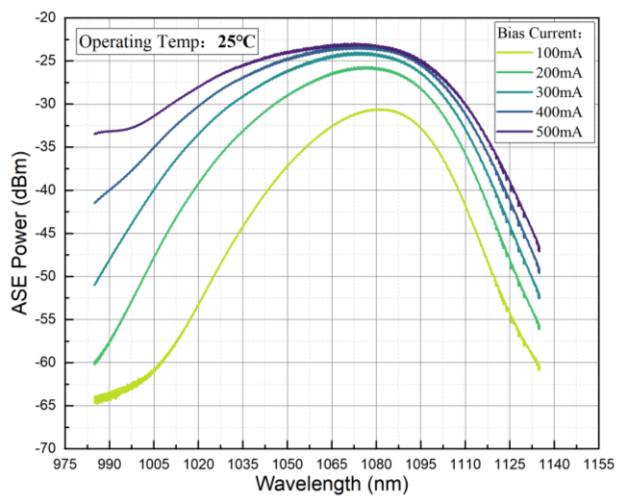


Pin Assignments			
1	TEC (+)	14	TEC (-)
2	Thermistor	13	GND
3	NC	12	NC
4	NC	11	Chip (-)
5	Thermistor	10	Chip (+)
6	NC	9	NC
7	NC	8	NC

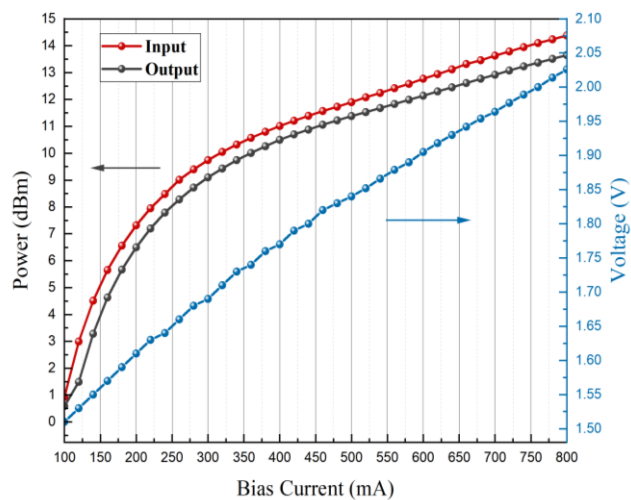
Note: Pin#1 is marked by a bevel (notch) at the base of the housing

典型特征曲线

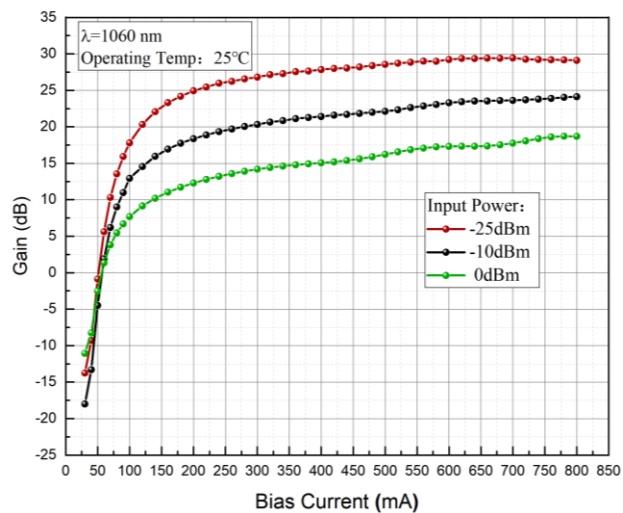
ASE spectra



ASE LIV characteristics



Gain vs. Current (different input power)



Gain vs. Output power

